

	<h2 style="color: red;">SI4812BDY-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4812BDY-T1-GE3</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 7.3A 8-SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4812BDY-T1-GE3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 425000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4812BDY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 7.3A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	425000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 9.5A, 10V
Verlustleistung (max)	1.4W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.3A (Ta)

SI4812BDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4812BDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4812BDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4812BDY-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4812BDY-T1</b> VISHAY SI4812BDY-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI4812BDY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 7.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4812DY-T1-E3</b> VISHAY SI4812DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4812DY-T1-E3 SOP8</b> VISHAY SI4812DY-T1-E3 SOP8 VISHAY</p>
 <p><b>SI4812BDY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 7.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4812DY</b> SILICON SI4812DY SILICON</p>	 <p><b>SI4812DY-T1-E3.</b> VIS SI4812DY-T1-E3. VIS</p>	 <p><b>SI4812BDY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 7.3A 8-SOIC</p>

### SI4812BDY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

SI4812BDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SI4812BDY-T1-GE3 Datenblatt	SI4812BDY-T1-GE3-Datenblätter	SI4812BDY-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI4812BDY-T1-GE3
SI4812BDY-T1-GE3 Electronic	SI4812BDY-T1-GE3-Komponenten	SI4812BDY-T1-GE3-Verteiler	SI4812BDY-T1-GE3-Bild	SI4812BDY-T1-GE3-Teil
SI4812BDY-T1-GE3 Preis	SI4812BDY-T1-GE3 Hersteller	SI4812BDY-T1-GE3 Bild	SI4812BDY-T1-GE3 Aktie	SI4812BDY-T1-GE3 Inventar
SI4812BDY-T1-GE3 Neu	SI4812BDY-T1-GE3 Original	SI4812BDY-T1-GE3 garantiert	SI4812BDY-T1-GE3 RFQ	SI4812BDY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited